

東芝ダイオード シリコンエピタキシャルプレーナ形

# 1SV323

○ TCXO/VCO 用

- 容量比が大きい。 :  $C_{1V}/C_{4V} = 4.3$  (標準)
- 直列抵抗が小さい。 :  $r_s = 0.4 \Omega$  (標準)
- 2端子小型外圍器なので、セットの小型化に適しています。

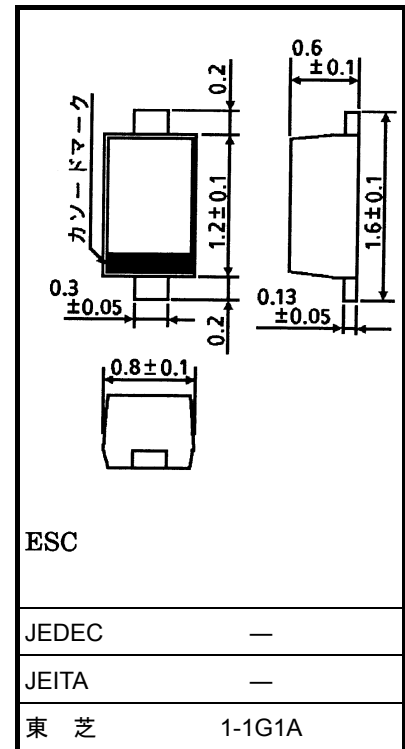
絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位
逆電圧	$V_R$	10	V
接合温度	$T_j$	125	°C
保存温度	$T_{stg}$	-55~125	°C

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。

弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

単位: mm



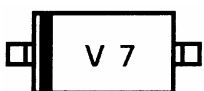
質量: 0.0014 g (標準)

電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
逆電圧	$V_R$	$I_R = 1 \mu A$	10	—	—	V
逆電流	$I_R$	$V_R = 10 V$	—	—	3	nA
容量	$C_{1V}$	$V_R = 1 V, f = 1 MHz$	26.5	—	29.5	pF
容量	$C_{4V}$	$V_R = 4 V, f = 1 MHz$	6.0	—	7.1	pF
容量比	$C_{1V}/C_{4V}$	—	4.0	4.3	—	—
直列抵抗	$r_s$	$V_R = 4 V, f = 100 MHz$	—	0.4	0.8	$\Omega$

注: 容量測定時の測定信号レベル:  $V_{sig} = 500 mV_{rms}$

現品表示



製品量産開始時期  
1999-03

